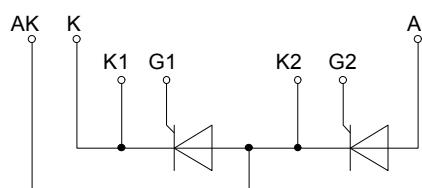
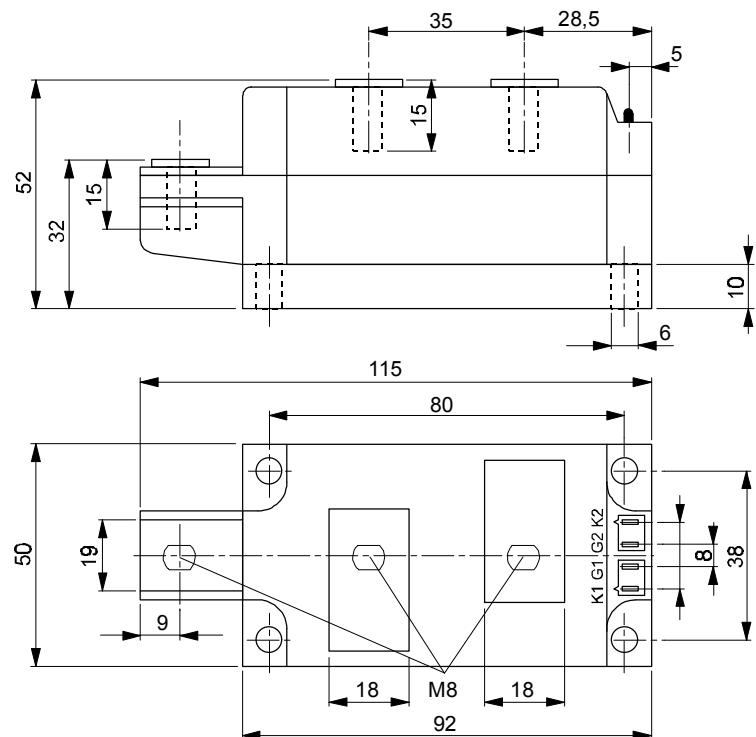


European Power-
Semiconductor and
Electronics Company
GmbH + Co. KG

Marketing Information TT 170 N



TT 170 N, TD 170 N, DT 170 N

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties					
<i>Höchstzulässige Werte</i>		<i>Maximum rated values</i>					
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	600 1200	800 1400	1000 1600	V
Vorwärts-Spitzenperrspannung	non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$			1800	V
Rückwärts-Spitzenperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$		+ 100		V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current		I_{TRMSM}		350		A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_c = 85^\circ\text{C}$ $t_c = 68^\circ\text{C}$	I_{TAVM}		170		A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\ \text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ \text{ms}$	I_{TSM}		223		
Grenzlastintegral	$\int i^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\ \text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ \text{ms}$	$\int i^2 dt$		5200		A
Kritische Stromteilheit	current	$V_D \leq 67\%, V_{DRM}, f_0 = 50\ \text{Hz}$	$(di/dt)_{cr}$		4600		A
Kritische Spannungsteilheit	voltage	$V_L = 10\text{V}, i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,67\ V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$		106000		A ² s
					150		A ² s
					1000		V/ μ s
<i>Charakteristische Werte</i>		<i>Characteristic values</i>					
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 600\ \text{A}$	V_T		max.1,65		V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$		0,95		V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	r_T		1	m Ω	
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\ \text{V}$	I_{GT}		max. 200	mA	
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\ \text{V}$	V_{GT}		max. 2	V	
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 6\ \text{V}$	I_{GD}		max.10	mA	
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,5\ V_{DRM}$	V_{GD}		max.0,2	V	
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\ \text{V}, R_A = 5\ \Omega$	I_H		max. 300	mA	
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\ \text{V}, R_{GK} \geq 10\ \Omega$ $i_{GM} = 1\ \text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}, t_g = 20\ \mu\text{s}$	I_L		max.1,2	A	
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	i_D, i_R		max. 50	mA	
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 1\ \text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}		max. 3	μ s	
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe Techn. Er./see Techn. Inf.	t_q		typ.250	μ s	
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V_{ISOL}		3	kV	
<i>Thermische Eigenschaften</i>		<i>Thermal properties</i>					
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^\circ\text{el.sinus: pro Modul/per module}$ DC: pro Zweig/per arm	R_{thJC}		max.0,085	°C/W	
		pro Modul/per module			max.0,17	°C/W	
		pro Zweig/per arm			max.0,082	°C/W	
Übergangs-Wärmewiderstand	heatsink	pro Modul/per module	R_{thCK}		max.0,164	°C/W	
		pro Zweig/per arm			max.0,02	°C/W	
Höchstzul. Sperrschiichttemperatur	max. junction temperature	$t_{vj\ max}$			125	°C	
Betriebstemperatur	operating temperature	$t_{c\ op}$			-40...+125	°C	
Lagertemperatur	storage temperature	t_{stg}			-40...+130	°C	
<i>Mechanische Eigenschaften</i>		<i>Mechanical properties</i>					
Gehäuse, siehe Seite	case, see page				1		
Si-Elemente mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact						
Innere Isolation	internal insulation						AlN
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1		6	Nm	
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +/- 5%/-10%	M2		12	Nm	
Gewicht	weight		G		typ.800	g	
Kriechstrecke	creepage distance				17	mm	
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz			5 . 9,81	m/s ²	

Diese Module können auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden.

These modules can also be supplied with common anode or common cathode.

Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

TT 170 N

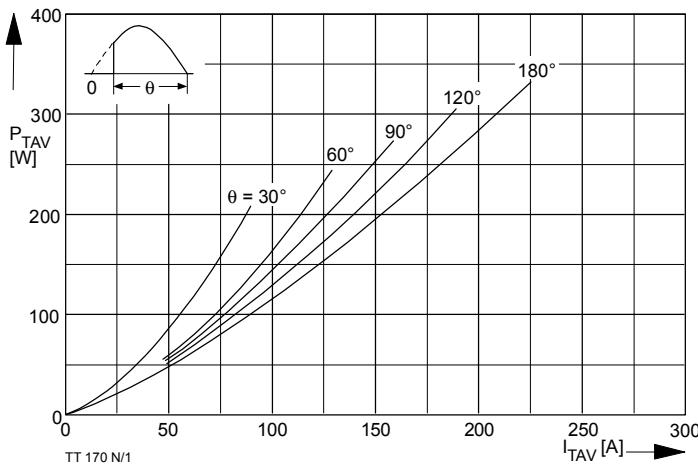


Bild / Fig. 1

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

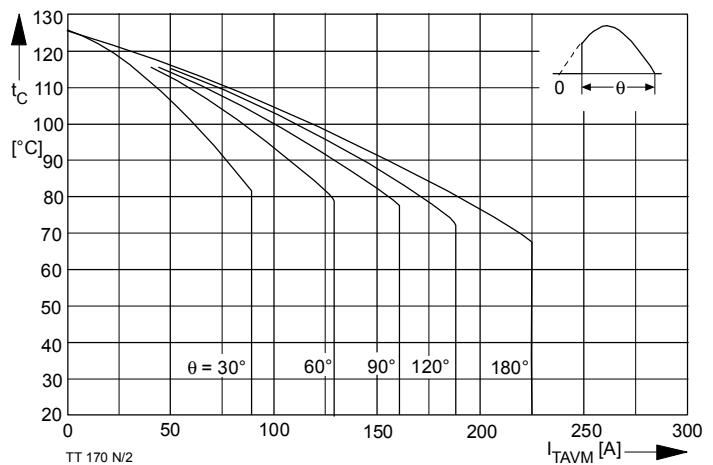


Bild / Fig. 2

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
 Strombelastung je Zweig / current load per arm
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

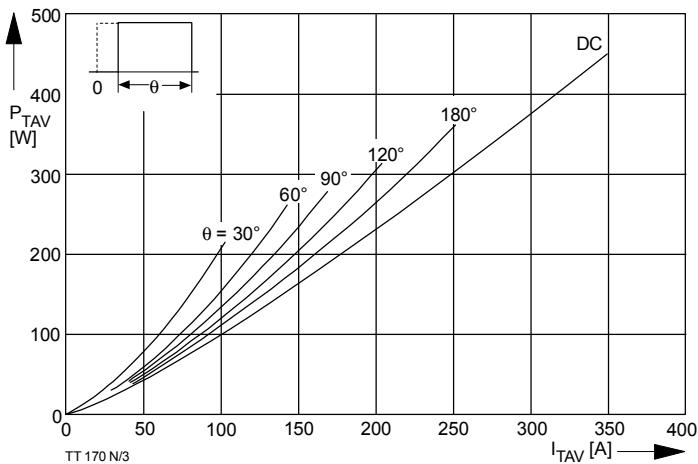


Bild / Fig. 3

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

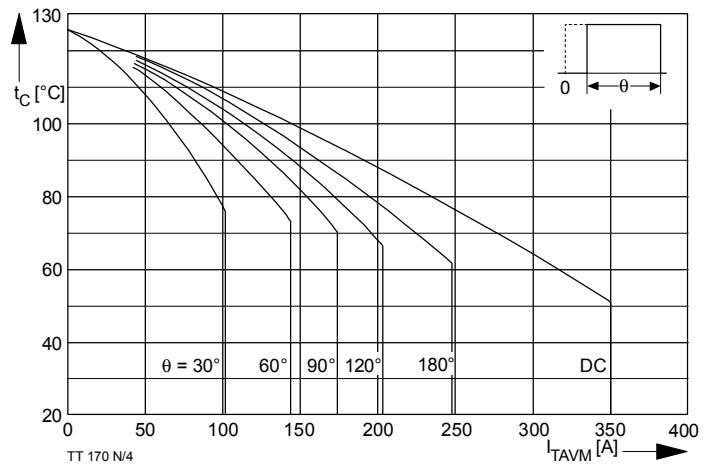


Bild / Fig. 4

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
 Strombelastung je Zweig / current load per arm
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

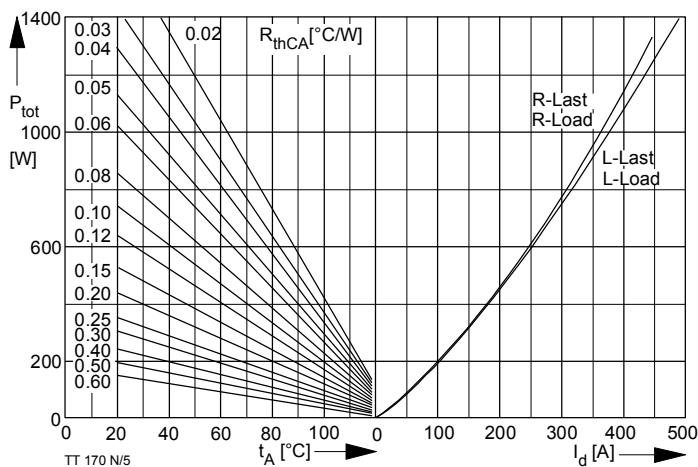


Bild / Fig. 5

B2 - Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit
 Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
 Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
 Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

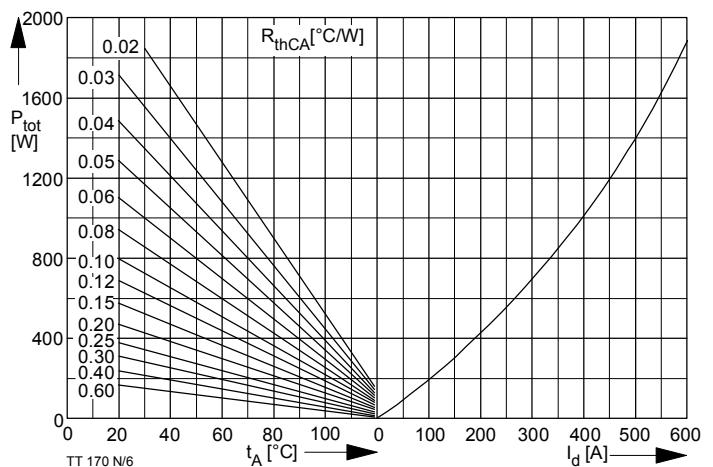


Bild / Fig. 6

B6 - Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit
 Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
 Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
 Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

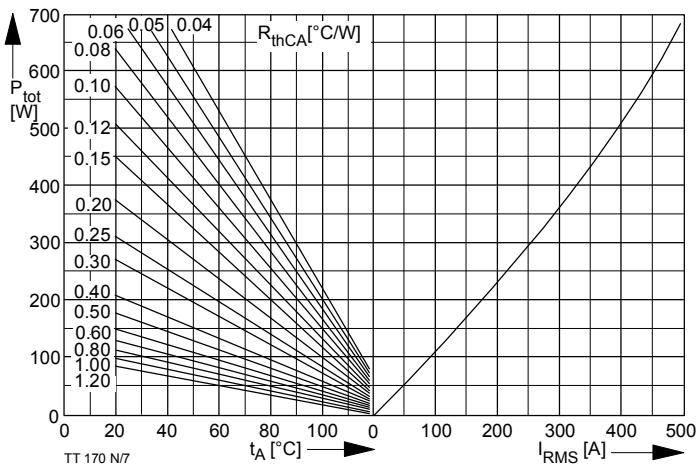


Bild / Fig. 7

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. at the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

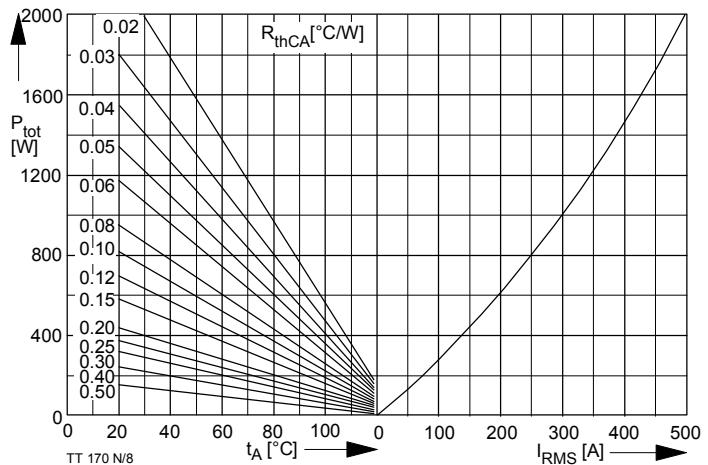


Bild / Fig. 8

W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum rated RMS current per phase I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. at the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

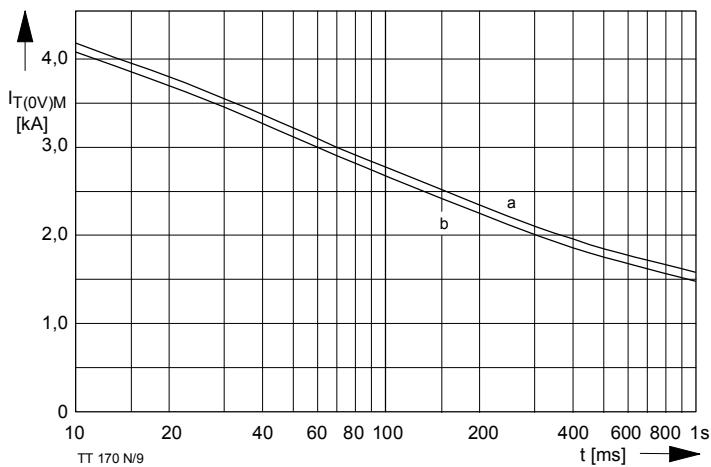


Bild / Fig. 9

Grenzstrom je Zweig $I_{T(OV)M}$: Belastung aus Leerlauf, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Maximum overload on-state current per arm $I_{T(OV)M}$: Surge current under no-load conditions, $V_R = 0,8 V_{RRM}$
a - $t_A = 35$ °C, verstärkte Luftkühlung / forced cooling
b - $t_A = 45$ °C, Luftseltbstkühlung / natural cooling

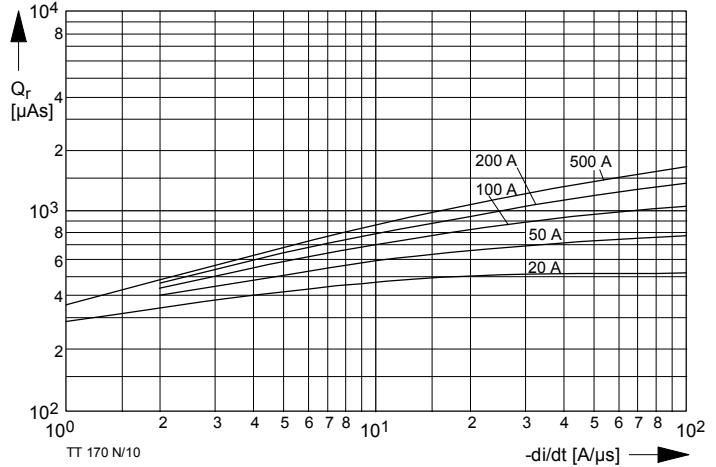


Bild / Fig. 10

Sperrverzögerungsladung / Recovery charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vjmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

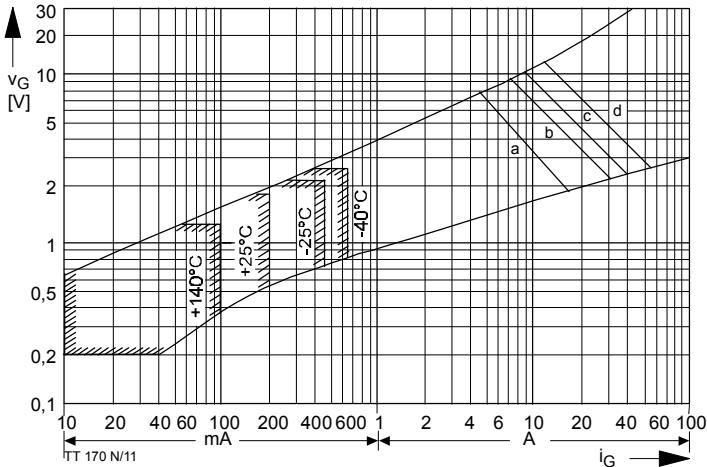


Bild / Fig. 11

Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas, $v_G = f(i_G)$, $v_D = 6 V$
Parameter:
Steuerimpulsdauer / Pulse duration t_g [ms] a b c d
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 40 80 100 150

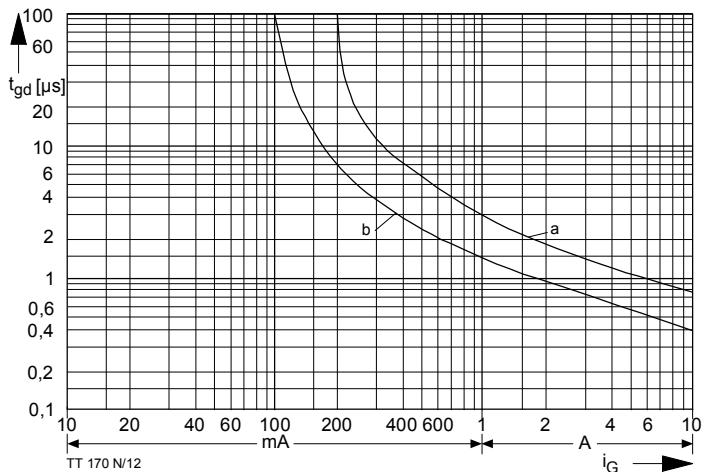


Bild / Fig. 12

Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_G)$
 $t_{vj} = 25$ °C, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu s$
a - äußerster Verlauf / limiting characteristic
b - typischer Verlauf / typical characteristic

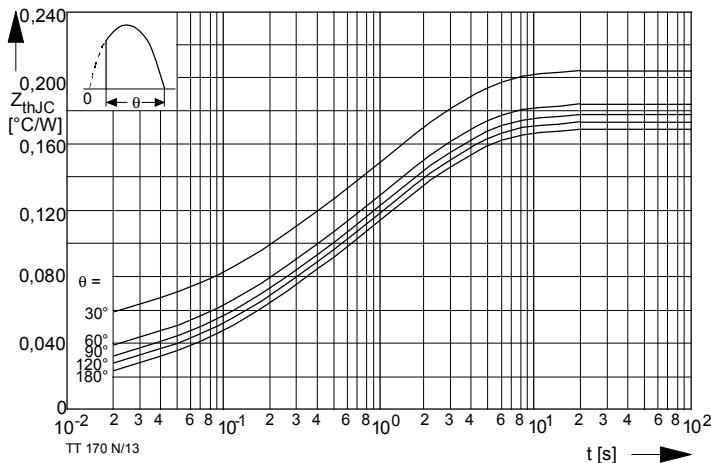


Bild / Fig. 13

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

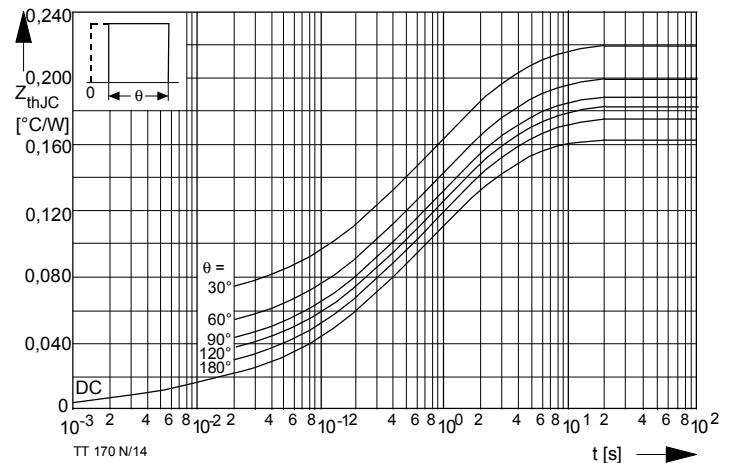


Bild / Fig. 14

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]	0,0039	0,0097	0,0291	0,0552	0,0661		
τ_n [s]	0,0008	0,008	0,085	0,54	2,85		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$